

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2006-3099(P2006-3099A)

【公開日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2006-001

【出願番号】特願2004-176853(P2004-176853)

【国際特許分類】

**G 0 1 L 9/00 (2006.01)**

**H 0 1 L 29/84 (2006.01)**

【F I】

G 0 1 L 9/00 3 0 3 E

G 0 1 L 9/00 3 0 3 F

H 0 1 L 29/84 B

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月5日(2007.6.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項11

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項11】

ダイヤフラム部を有する半導体基板に1つ以上の歪み検出素子が設けられた半導体圧力センサの製造方法において、

前記半導体基板に前記歪み検出素子を形成する工程と、

前記半導体基板に前記ダイヤフラム部を形成する工程とを有し、

前記歪み検出素子の少なくとも1つを、前記ダイヤフラム部に第1の端部を有し、該第1の端部と前記ダイヤフラム部のエッジ間の距離をLXとしたとき、LX 20 μmとなるように、前記ダイヤフラム部の内側と外側とに跨って配置することを特徴とする半導体圧力センサの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

SOI基板2は、半導体材料としてのシリコンからなる支持層2aと表面層2cとの間に埋め込み酸化膜(絶縁層)2bが介在した3層構造の基板である。このSOI基板2の一部の領域において、支持層2aが除去されることで、残りの埋め込み酸化膜2bおよび表面層2cの部分でダイヤフラム3が構成される。